

10/27/526  
07/15/04

DIALOG(R)File #351:Derwent WPI  
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008957719 \*\*Image available\*\*  
WPI Acc No: 1992-084988/ 199211

XRPX Acc No: N97-439042

Multi-electron beam source for image display apparatus - includes rectifying element which is connected in parallel to electron emitting elements of row of electron emitting elements for removing spike-like noise generated by driving circuit

Patent Assignee: CANON KK (CANON )

Inventor: KANEKO T; NOMURA I; ONO H; SUZUKI H

Number of Countries: 002 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 4028137	A	19920130	JP 90131347	A	19900523	199211 B
US 5682085	A	19971028	US 9310436	A	19930128	199749
			US 9357544	A	19930506	
			US 95467900	A	19950606	
JP 2967288	B2	19991025	JP 90131347	A	19900523	199950
US 6157137	A	20001205	US 9310436	A	19930128	200066 N
			US 9357544	A	19930506	
			US 95467900	A	19950606	
			US 97956170	A	19971022	

Priority Applications (No Type Date): JP 90131347 A 19900523; US 97956170 A 19971022

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 4028137	A		8		
US 5682085	A	26	G09G-003/10	CIP of application US 9310436 Cont of application US 9357544	
JP 2967288	B2		8	H01J-001/30	Previous Publ. patent JP 4028137
US 6157137	A			G09G-003/10	CIP of application US 9310436 Cont of application US 9357544 Cont of application US 95467900 Cont of patent US 5682085

Abstract (Basic): US 5682085 A

The multi-electron beam source includes electron emitting elements which are provided two-dimensionally in a matrix like arrangement on a substrate. Opposing terminals of electron emitting elements are arranged adjacently in the column direction thereof being electrically connected to each other. Terminals arranged on the same side of all the electron emitting elements in the same row are electrically connected. The electron emitting elements are arranged in "'m'" rows, "'m'" representing a number of two or more.

A driving circuit drives the electron emitting elements. The multi-electron beam source is able to prevent a spike like voltage using a rectifying element which is connected in parallel with the electron emitting elements of a row of electron emitting elements for removing a spike-like noise superimposed onto the driving pulse generated by the driving circuit and a resistor

connected in series to the rectifying element.

USE/ADVANTAGE - Abnormal (instantaneous high) voltage can be prevented. Switching elements are protected.

Title Terms: MULTI; ELECTRON; BEAM; SOURCE; IMAGE; DISPLAY; APPARATUS; RECTIFY; ELEMENT; CONNECT; PARALLEL; ELECTRON; EMIT; ELEMENT; ROW; ELECTRON; EMIT; ELEMENT; REMOVE; SPIKE; NOISE; GENERATE; DRIVE; CIRCUIT

Derwent Class: P85; T04; U12; V05; W03

International Patent Class (Main): G09G-003/10; H01J-001/30

International Patent Class (Additional): H01J-031/12

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S+X): V05-D01B3C; V05-D01C5; V05-D05C5; V05-D05C5C

W03-A08A8C; W03-A08X

①日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

②公開特許公報(A)

平4-28137

③Int.Cl.

H 01 J  
31/12

識別記号

序内整理番号

A 9058-5E  
B 6722-5C

④公開 平成4年(1992)1月30日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

⑤発明の名称

マルチ電子ビーム源及びこれを用いた画像表示装置

⑥特許 平2-131347

⑦出願 平2(1990)5月23日

⑧発明者 堀 義俊

英 俊

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

⑨発明者 野村 一郎

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

⑩発明者 小野 治人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

⑪発明者 金子 哲也

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

⑫出願人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑬代理人 弁理士 斎藤 善雄

外1名

明細書

1. 発明の名称

マルチ電子ビーム源及びこれを用いた  
画像表示装置

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に複数の電子放出素子を2次元的に行列状に配設し、行方向に配列された隣接する電子放出素子の対向する端子同士を電気的に結線するとともに、列方向に配列された同一列上の全電子放出素子の同じ側の端子同士を電気的に結線してなり、前記列方向の複数の電子放出素子は2列以上の中間にわたりて置かれられ、かつ、前記中列の電子放出素子の各列には、電子放出素子と並列して遮光素子が設けられていることを特徴とするマルチ電子ビーム源。

(2) 請求項1記載のマルチ電子ビーム源を用い、その上方に、該マルチ電子ビーム源を構成する2次元に配列された電子放出素子の行方向にグリッド電極を配設し、さらにその上方に、電子

ビームの照射により映像を可視化する為の蛍光体ターゲットを配置したことを特徴とする画像表示装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、多数の電子放出素子を複数列にわたり配列形成したマルチ電子ビーム源及びこれを用いた画像表示装置に関するものである。

【従来の技術】

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム・アイ・エリンソン(M. I. Ellinson)等によって発表された冷陰極素子が知られている。〔ラジオ エンジニアリング エレクトロニクス フィジックス(Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1290~1296頁、1965年〕。

これは、基板上に形成された小面積の導線に、該導線に平行に電流を供することにより、電子放出が生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導形電子放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形電子放出素子としては、前記

エリンソン等により開発された  $\text{SnO}_x(\text{Sb})$  膜を用いたもの、Au薄膜によるもの【ジー・ディトマー・スイン・ソリド・フィルム】(G. Dittmer: "Thin Solid Films" ), 9巻, 317頁, (1972年)], ITO 膜によるもの【エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンストラッダ: "アイ・イー・イー・トランジスト" イー・ディー・コンフ(M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf.", 319頁, (1975年)], カーボン膜によるもの【宮木久徳: "真空", 第26巻, 第1号, 22頁, (1983年)】などが報告されている。

また、表面伝導形電子放出素子以外にも、MINI形電子放出素子や微細な電界放射電子線(C. A. Spindt et al., J. Appl. Phys., Vol. 47, No. 12, P5248, 1976)などの冷陰極素子が報告されている。

これらの冷陰極素子は、

- 1) 高い電子放出効率が得られる
- 2) 構造が簡単であるため、製造が容易である

3) 同一基板上に多数の素子を配列形成できる等の利点を有する。

そこで、これらの冷陰極素子を多段偏置にして配列させ、しかも電気配線の抵抗を低減する方法として、本発明者は第6図に示すような方法を更に提案した。図中ESは電子放出素子で、 $E_1 \sim E_{n-1}$ は配線電極を示しており、 $n$ 列の電子放出素子列が配列形成されている。

本装置は、任意の一列を選択的に駆動する事が可能で、例えば電極 $E_1$ に $V_s [V]$ 、電極 $E_2 \sim E_{n-1}$ に $0 [V]$ を印加すれば、第1列の素子にのみ $V_s [V]$ の駆動電圧が印加され、この列の素子のみ電子ビームを放出する。一般的には、第n列を駆動する為には、電極 $E_1 \sim E_n$ に $V_s [V]$ を印加し、電極 $E_2 \sim E_{n-1}$ に $0 [V]$ を印加すればよく、また、どの列も駆動しない場合には $E_1 \sim E_{n-1}$ を全て同電位(例えば $0 [V]$ )にすればよい。

このような列選次駆動が可能なマルチ電子ビーム源は、素子列と直交するグリッド電極を設けることにより、XYマトリクス形の電子ビーム源を構

成することが容易な為、例えば平板形CRTなどへの応用が大いに期待されるところである。

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、第6図に示すマルチ電子ビーム源を電気回路で駆動する場合、本来休止中の素子列にスパイク状の電圧が印加されるという問題が発生していた。第7図と第8図は、かかる問題を説明する為の図である。

まず第7図は、前記第6図のマルチ電子ビーム源を駆動する為に用いる回路の典型例を示したものである。図中、 $E_1 \sim E_{n-1}$ の各配線電極には、例えば電界効果トランジスタ(FET)のようなスイッチング素子がトータル・ポール型に接続されており、各FETのゲート端子 $GP_1 \sim GP_{n-1}$ および $GN_1 \sim GN_{n-1}$ を適宜制御することにより、各配線電極には $0 [V]$ (グランドレベル)か又は $V_s [V]$ が選択的に印加できるものである。

第8図は、前記第7図のマルチ電子ビーム源を駆動する際、各部に印加される電圧を表示するグラフである。図中に示すように、休止期間を

はさみながら、第1列目から順次素子列を駆動してゆく場合を想定する。(かかる駆動手段は、マルチ電子ビーム源を平板形CRTなどに応用する場合一般に行われる方法である。)

この様な駆動を行うにあたり、配線電極 $E_1 \sim E_n$ には、周囲の $\sim$ に示すようなタイミングで $V_s [V]$ の矩形電圧パルスが印加される。例えば、電子放出素子の第1列目には $\circ$ と $\bullet$ の差電圧が印加されるのであるから、 $\circ$ で示される第1列駆動タイミングにおいてのみ $V_s [V]$ がかかる事になる。以下同様に、第2列目には $\circ$ と $\bullet$ の差電圧、第3列目には $\circ$ と $\bullet$ の差電圧が印加されることになる。

しかしながら、各素子列に印加される電圧を、実際にオシロスコープなどを用いて観測してみると、周囲 $\circ$ ～ $\bullet$ に示すように、他の素子列をオンまたはオフするタイミングにおいて、スパイク状の電圧 $SP_{n-1}$ (図中点線で示す)または $SP_{n-1}$ (図中実線で示す)が印加されることが判った。

このようなスパイク状の電圧のうち、逆方向電圧 $SP_{n-1}$ が電子放出素子に印加される場合には、

電子の電子放出特性の劣化が著しく早くなったり、あるいは同時に破壊されることがある。かかるマルチ電子ビーム顕を表示装置などへ応用するうえで大きな問題となっていた。

この様なスパイク状の電圧が発生するのは、前記①～④に示した各電極への印加電圧波形に時間的つなずれが生じている点と考られるが例えば第1列目の場合、第2列目以後の電子列をオン（またはオフ）するタイミングにおいて、電極E<sub>1</sub>と電極E<sub>2</sub>は同時に0[V]→V<sub>1</sub>[V]（またはV<sub>2</sub>[V]）→0[V]へスイッチするべきであるが、このタイミングにずれがあると④に示したようなスパイク状の電圧が印加されてしまうわけである。

その際、正電圧のスパイクSP<sub>1...n</sub>となるか、負電圧のスパイクSP<sub>2...n</sub>となるかは、E<sub>1</sub>印加電圧とE<sub>2</sub>印加電圧のうちどちらが先行してスイッチしたかによって決まるものである。

各電極に印加する電圧波形に時間的なつなずれが生じる原因としては、前記第7図で示した駆動回路のFETのゲート信号GP<sub>1...n</sub>, GP<sub>2...n</sub>, GN<sub>1...n</sub>が

されていたり、あるいは、FETの特性ばらつきによりスイッチング時間がばらつくことなどが挙げられる。

しかしながら、前記ゲート信号のずれや、FET特性のばらつきを電気回路的に調整して、スパイク状の印加電圧SP<sub>1...n</sub>を完全に解消することは、技術的に非常に困難であり、またコストの面から見ても現実的な解決策とは言えなかった。

すなわち、本発明の目的とするところは、上述のような問題を克服したマルチ電子ビーム顕及びこれを用いた画像表示装置を提供することにある。

#### 【課題を解決するための手段及び作用】

本発明の特徴とするところは、基板上に複数の電子放出電子を2次元的に行列状に配置し、行方向に配列された隣接する電子放出電子の対向する端子同士を電気的に結線するとともに、列方向に配列された同一列上の全電子放出電子の同じ側の端子同士を電気的に結線してなり、前記列方向の複数の電子放出電子は2列以上の単列にわたって

設けられ、かつ、前記単列の電子放出電子の各列には、電子放出電子と並列して整流電子が設けられているマルチ電子ビーム顕としている点にある。

また、上述マルチ電子ビーム顕を用い、その上方に、該マルチ電子ビーム顕を構成する2次元に配列された電子放出電子の行方向にグリッド電極を配列し、さらにその上方に、電子ビームの照射により映像を可視化する為の露光体ターゲットを配置した画像表示装置をも特徴とするものである。

すなわち、本発明によれば、前記電子放出電子列の各列に、電子放出電子と電気的に並列結線として整流電子を設けることにより、前記スパイク状の逆電圧SP<sub>1...n</sub>が印加されることによる電子放出電子の破壊あるいは特性の劣化という問題を防止したものである。

以下、実施例を用いて本発明を具体的に説述する。

〔実施例〕

#### 【実施例】

第1図は、本発明の第1の実施例を示す図で、図中の電子放出電子ES、配線電極E<sub>1</sub>～E<sub>n</sub>および駆動電圧印加用スイッチング電子(FET)は、前記従来技術の項で説明したものと同様である。本図中Dで示すのは、整流用ダイオードであり、各電子放出電子列毎に、電子放出電子と並列して設けられている。かかるダイオードDの働きは、任意のn列において、アノードが配線電極E<sub>1...n</sub>に、カソードが配線電極E<sub>2...n</sub>に接続されている。

かかる構成によれば、前記第8図で説明した駆動手順に従って電子放出電子列を駆動する際、ダイオードDに対して、電子放出電子の駆動電圧V<sub>d</sub>は逆方向電圧として働き、スパイク状電圧SP<sub>1...n</sub>は順方向電圧として働くものである。

従って、かかるダイオードDの働きにより、各電子放出電子列に印加される電圧波形は、第2図①, ②, ③に示すようになる(尚、各々のグラフは、前記第8図の①, ②, ③の電圧波形に対応している。)。

すなわち、各電子放出素子列には、スパイク状の逆電圧  $SP_{1-1}$  が印加されない為、従来問題となっていた電子放出素子の特性劣化や破壊といった現象は発生しなくなり、マルチ電子ビームの寿命を実用レベルにまで延ばすことに成功した。

次に、本発明適用のマルチ電子ビーム源を平板形圖像表示装置に応用した例を第3図に示す。以下、その構成と動作について概要的に説明する。

本図において、TCはガラス製の真空容器で、その一部であるFPは、表示面側のフェースプレートFPを示している。フェースプレートFPの内面には、たとえばITOを材料とする透明電極が形成され、さらにその内面には、赤、緑、青の蛍光体がマイクロ状に塗り分けられ、CRTの分野では公知のメタルバッカ処理が施されている。(透明電極、蛍光体、メタルバッカは図示せず。)また、前記透明電極は、加速度電圧を印加するために、端子EVを通じて真空容器外と電気的に接続されている。

また、Sは前記真空容器TCの底面に固定されたガラス基板で、その上面には、電子放出素子が

$N \times S$  列にわたり配列形成されている。該電子放出素子群は、配線  $E_1, E_2, E_3, \dots$  により列毎に電気的に並列接続されており、各配線  $E_1, E_2, E_3, \dots$  は、各々端子  $E_{11}, E_{12}, E_{13}, \dots, E_{1n}, E_{21}, E_{22}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{S1}, E_{S2}, E_{S3}, \dots, E_{Sn}$  によって、真空容器外と電気的に接続されている。かかる端子  $E_{11} \sim E_{Sn}$  は、絶縁材料よりなる基板104に設けられた配線パターン103を介して、図示外の駆動回路と電気的に接続されている。また、各配線パターン103には、ダイオード105が接続されているが、これらは前記第1図で説明したダイオードDに相当するものである。

尚、図中の円内に省略図示したものは、電子放出素子の一例であり、正極101及び負極102及び電子放出部103より成る表面伝導形放出素子を示している。中子101は、電子放出部103の上に位置する。

また、基板SとフェースプレートFPの中間に、ストライプ状のグリッド電極G3が設けられている。グリッド電極G3は、前記素子列と直交して、N本設けられており、各電極には電子ビームを通過するための空孔G6が設けられている。空孔G6

は、第3図の例のように各電子放出素子に対応して1個づつ設けててもよいし、あるいは微小な孔をメッシュ状に多数設けててもよい。各グリッド電極は、端子G1～Gnによって真空容器外と電気的に接続されている。

本装置では、2個の電子放出素子列とN個のグリッド電極列により、Yマトリクスが構成されているため、電子放出列を一列づつ順次駆動(走査)するのと同時にグリッド電極列に画像1ライン分の変調信号を同時に印加することにより、各電子ビームの蛍光体への照射を制御し、画像を1ラインづつ表示していくものである。

さて、同様な構成でダイオード105を備えていなかった従来の表示装置においては、数十～数百時間程度で輝度むらや画素欠陥等実用上問題となる画質劣化が比較的高い頻度で発生していたが、本実施例の表示装置においては、少なくとも千時間以上にわたり、電子放出素子の特性劣化による画質劣化は発生しなかった。

## 実施例2

第4図は、前記第1実施例のダイオードDの代わりに、ツェナーダイオードZDを接続した場合を示すものである。この場合には、第1実施例と異なり、スパイク状逆電圧  $SP_{1-1}$  が電子放出素子に印加されるのを防止する効果があるのはもちろんであるが、適当なツェナー電圧(例えば、 $1.3 \times V_s$  [V])を選択することにより、正常性の異常電圧( $1.3 \times V_s$  [V]を超える電圧)が電子放出素子に印加されるのを防止する効果も兼ねることができる。

第5図は、前記第1実施例のダイオードDと並列に電流制限抵抗 $r$ を接続した例で、スパイク状逆電圧  $SP_{1-1}$  に伴い、スイッチング素子に接続されるスパイク状の電流を制限するためのものである。ただし、不必要的電力消費を抑える為に、電流制限抵抗 $r$ の値は電子放出素子一列の並列抵抗よりも十分小さいことが望ましい。例えば、電子放出素子1素子の抵抗値 $10\text{K}\Omega$ のものが、100素子並列接続されている場合には、1列の並列抵抗は $100\text{ }\Omega$ となるわけだが、この場合には $r$ として例

えば1口を用いれば、消費電力を大巾に増加させることなくスイッチング電子の保護抵抗として機能させることが可能である。

#### 【発明の効果】

以上説明したように、電気的に並列接続された電子放出電子列の各列に、並列に遮蔽電子を設けることにより、スパイク状の逆電圧が電子放出電子に印加されるのを防止する効果がある。その結果、電子放出電子の電子放出特性の劣化、あるいは駆動を防止することが可能となり、マルチ電子ビーム源の実用上の寿命を大巾に延長することができた。

また、本発明のマルチ電子ビーム源を平板形表示装置に応用することで、従来數十～数百時間で頻度むらや画面欠陥が発生していたものが、少なくとも千時間以上にわたって初期の画質を維持することが可能となり、実用性を大巾に向上させることができとなった。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係るマルチビーム電子源を

示した断面図である。

第2図は、本発明の効果を示す為の印加電圧のグラフである。

第3図は、本発明に係るマルチビーム電子源を用いた平板形表示装置の断面図である。

第4図は、本発明に係る遮蔽電子としてツェナーダイオードを用いたマルチビーム電子源を示す図である。

第5図は、第1図に示すマルチビーム電子源に電流制限抵抗を接続した電子源を示す図である。

第6図は、本発明の適用対象となるマルチビーム電子源の電子放出電子の配列を示す図である。

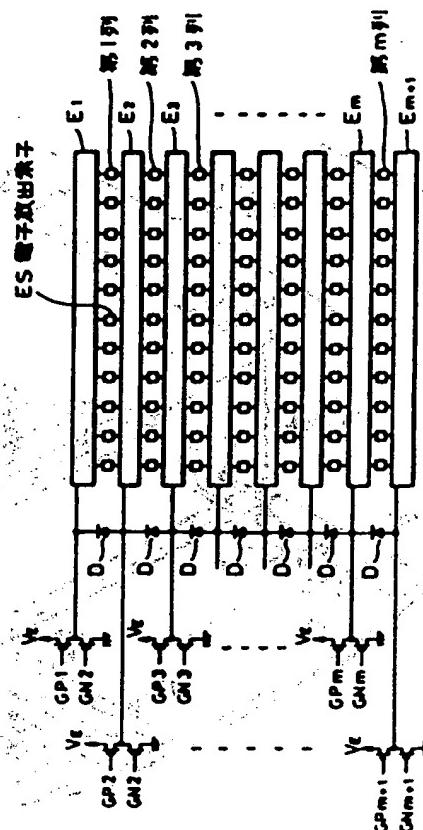
第7図は、第6図の電子源に用いられる駆動用スイッチング電子の例を示す図である。

第8図は、従来のマルチ電子ビーム源で問題となっていた、スパイク状逆電圧SP<sub>1..n</sub>を説明する為のグラフである。

ES—電子放出電子子 E<sub>1..n</sub>—配線電極  
D<sub>1..n</sub>—ダイオード ZD—ツェナーダイオード  
r—電流制限抵抗 VC—真空容器

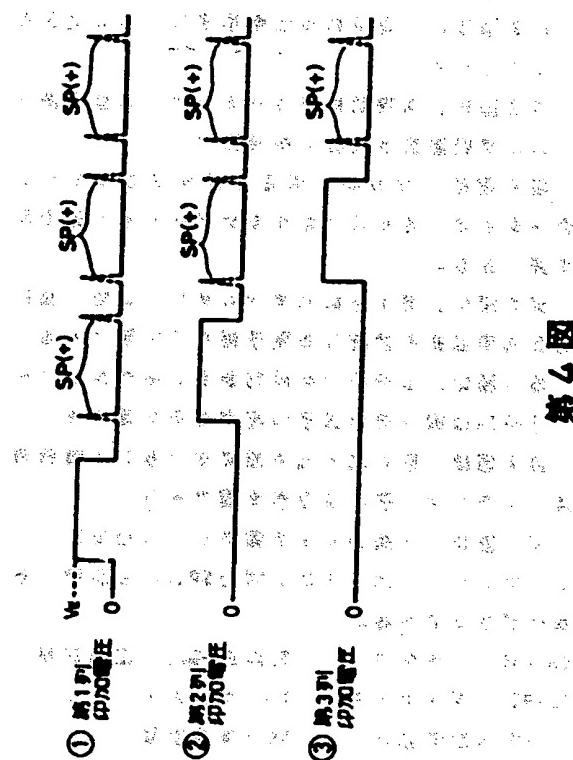
F—フェースプレート S—ガラス基板  
104—基板 106—配線バターン  
GR—グリッド電極 G<sub>b</sub>—空孔

出願人 キヤノン株式会社  
代理人 増田善雄  
・ 渡辺敬介

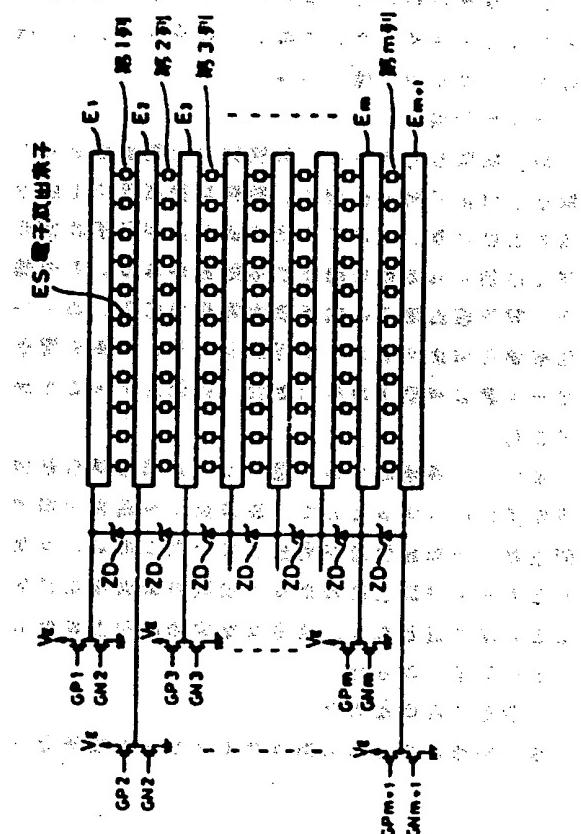


図一様

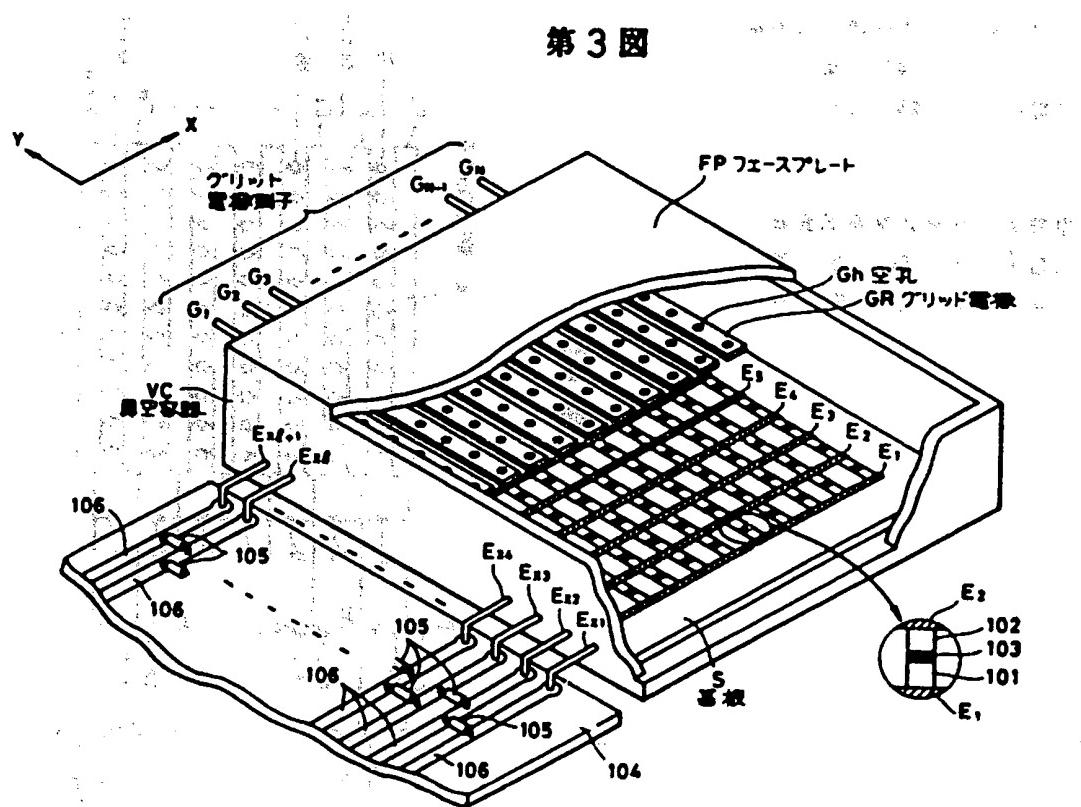
扫描于4-28137 (6)



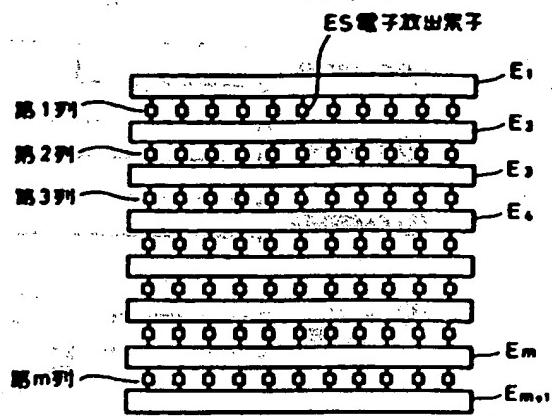
四  
第4



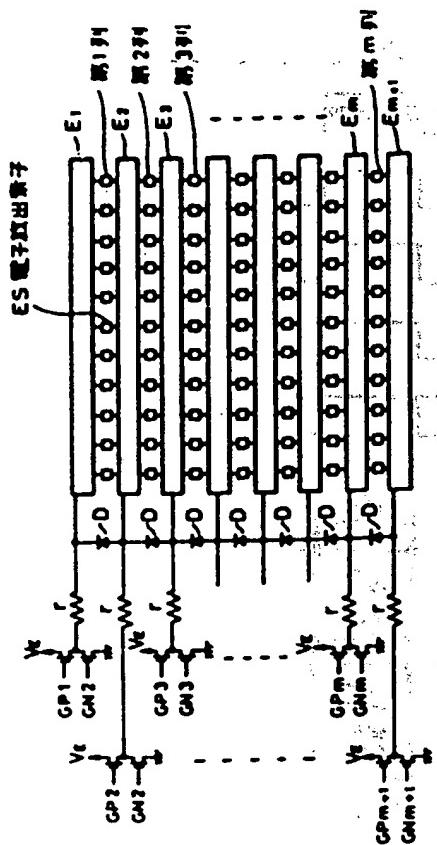
第3回



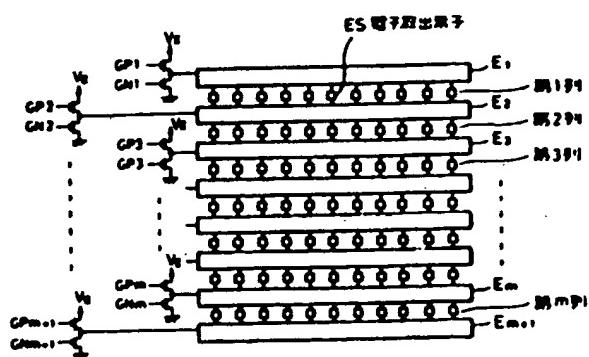
第6図



第5図



第7図



第8圖

